第六讲 线缺陷

主讲人:张骞

材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

线缺陷

位错模型的提出

背景

完整晶体塑性变形—滑移的模型→金属晶体的理论强度→理论强度比实测强度高出几个数量级→ 晶体缺陷的设想— 线缺陷(位错)的模型→ 以位错滑移模型计算出的晶体强度,与实测值基本相符。

应用

位错的来源与增殖

材料科学与工程学院

- 一、晶体的塑性和强度
- 二、位错的类型
- 三、位错的伯格斯矢量 (Burgers vector) 及位错的性质
- 四、位错的应力场与应变能
- 五、位错的运动
- 六、位错的反应

材料科学与工程学院

- 一、晶体的塑性和强度
- (一) 完整晶体的塑性变形方式
 - 1. 晶体在外力作用下的滑移
 - 2. 晶体在外力作用下的孪生
- (二) 完整晶体的理论切变强度

材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

(一) 完整晶体的塑性变形方式

1. 晶体在外力作用下的滑移

滑移的定义

滑移的结果

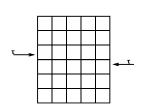
滑移的可能性 (滑移系统): 在最密排晶面 (称为滑移

面)的最密排晶向(称为滑移方向)上进行

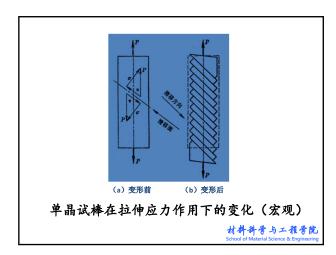
晶体滑移的临界分切应力(τ_c) : 开动晶体滑移系统所需的最小分切应力

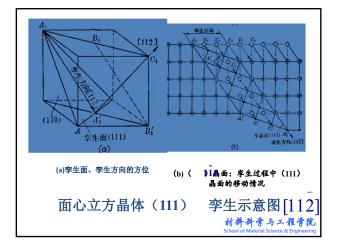
2. 晶体在外力作用下的孪生

在外力作用下,晶体的一部分相对于另一部分,沿着一定的晶面和晶向发生切变,切变之后,两部分晶体的位向以切变面为镜面呈对称关系。 材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering



外力作用下晶体滑移示意图(微观)





(二) 完整晶体的理论切变强度

按照完整晶体滑移模型,使晶体滑移所需的临界切应力,即使整个滑移面的原子从一个平衡位置移动到另一个平衡位置时,克服能垒所需要的切应力,晶面间的滑移是滑移面上所有原子整体协同移动的结果,这样可以把晶体的相对滑移简化为两排原子间的滑移,晶体的理论切变强度 C_m 为:

 $Gx/a=\tau_sin(2\pi x/\lambda)=\tau_s2\pi x/\lambda$

当x很小时,于是,

 τ_m = $G\lambda$ / ($2\pi a$)

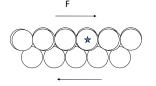
对于简单立方晶体, a=l, 则

 τ_m =G/ (2 π)

材料科学与工程学院

滑移机理

所施加的力必须足以使原子间的 键断裂,才能产生滑移压力大小约为 E/15



材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

二、位错的类型

晶体在不同的应力状态下,其滑移 方式不同。根据原子的滑移方向和位错线 取向的几何特征不同,位错分为刃位错、 螺位错和混合位错。

材料科学与工程学院

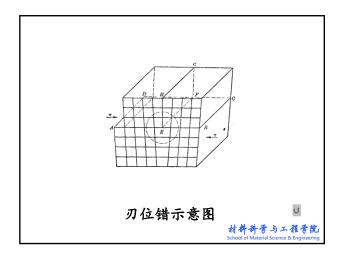
(一)、刃位错

形成及定义:

晶体在大于屈服值的切应力o作用下,以ABCD面为滑移面发生 滑移。EF是晶体已滑移部分和未滑移部分的交线,犹如砍入晶 体的一把刀的刀刃,即刃位错(或棱位错)。

几何特征: 位错线与原子滑移方向相垂直; 滑移面上部位错线周围原子受压应力作用, 原子间距小于正常晶格间距; 滑移面下部位错线周围原子受张应力作用, 原子间距大于正常晶格间距。

 $\frac{6}{9}$: 正刃位错," $_{\perp}$ "; 负刃位错," $_{\perp}$ "。符号中水平线代表滑移面,垂直线代表半个原子面。



(二)、螺位错

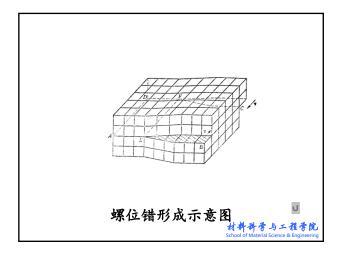
形成及定义:

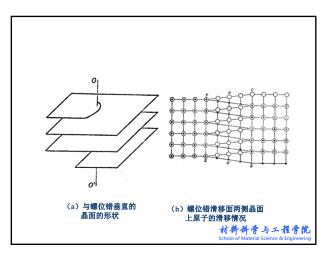
晶体在外加切应力o作用下,沿ABCD面滑移,图中EF 线为已滑移区与未滑移区的分界处。由于位错线周围的一组 原子面形成了一个连续的螺旋形坡面,故称为螺位错。

几何特征: 位错线与原子滑移方向相平行; 位错线周围原子的 配置是螺旋状的。

分类:有左、右旋之分,分别以符号"∪"和"∩"表示。其中 小圆点代表与该点垂直的位错,旋转箭头表示螺旋的旋转方向。它们之间符合左手、右手螺旋定则。

> 材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

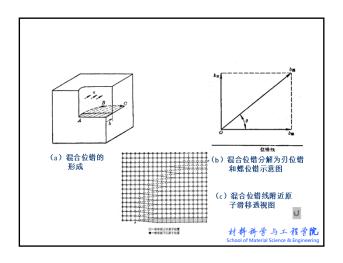




(三)、混合位错

在外力7作用下,两部分之间发生相对滑移,在晶体内部已滑移和未滑移部分的交线既不垂直也不平行滑移方向(伯氏矢量b),这样的位错称为混合位错。

位错线上任意一点, 经失量分解后, 可分解为刃位错和螺位错分量。晶体中位错线的形状可以是任意的, 但位错线上各点的伯氏矢量相同, 只是各点的刃型、螺型分量不同而已。



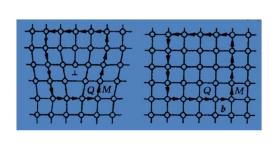
- 三、位错的伯格斯矢量 (Burgers vector) 及位错的性质
- 伯格斯矢量:晶体中有位错存在时,滑 移面一侧质点相对于另一侧质点的相对 位移或畸变。
- 性质: 大小表征了位错的单位滑移距离, 方向与滑移方向一致。

材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

(一)、伯格斯矢量的确定及表示

- 1. 确定伯格斯矢量的步骤
 - (1) 对于给定点的位错, 人为规定位错 线的方向,
 - (2) 用右手螺旋定则确定伯格斯回路方向。
 - (3) 按照规律走回路, 最后封闭回路的矢量即要求的伯氏矢量。
- 2.伯氏矢量的表示方法 b=ka[uvw]

材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering



简单立方结构中, 围绕刃位错的伯格斯回路

材料科学与工程学院

(二)、伯氏矢量的守恒性

对一条位错线而言, 其伯氏矢量是 固定不变的, 此即位错的伯氏矢量的守恒性。

推论:

- 1. 一条位错线只有一个伯氏矢量。
- 2. 如果几条位错线在晶体内部相交(交点称 为节点),则指向节点的各位错的伯氏矢量 之和,必然等于离开节点的各位错的伯氏矢 量之和。

材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

(三)、位错线的连续性及位错密度

1. 位错线的连续性

位错线不可能中断于晶体内部。 在晶体内部,位错线要么自成环状回路, 要么与其它位错相交于节点,要么穿过晶 体终止于晶界或晶体表面。

材料科学与工程学院

2. 位错密度: 单位体积内位错线的总长度 ρ=L/V

$$\rho = \frac{n \cdot l}{S \cdot l} = \frac{n}{S}$$

- 式中 L为晶体长度, n为位错线数目, S 晶体截面积。
- 一般退火金属晶体中 ρ 为 10^4 ~ 10^8 cm $^{-2}$ 数量级,经剧烈冷加工的金属晶体中, ρ 为 10^{12} ~ 10^{14} cm $^{-2}$

四、位错的应力场与应变能

理论基础:连续弹性介质模型

假设: 1. 完全服从虎克定律,即不存在塑性变形; 2. 各向同性; 3. 连续介质,不存在结构间隙。

位错的应力场:

刃位错上面的原子处于压应力状态,为压应力场, 刃位错下面的原子处于张应力状态,为张应力场。

围绕一个螺位错的晶体圆柱体区域也有应力场存在。

材料科学与工程学院

位错的应变能W_{tot}

位错使其周围点阵畸变,点阵能量增加,点阵所增加的 能量即为位错的应变能。包括两部分:Wtot=Woore+We/

- (1) 位错核心能 № , 在位错核心几个原子间距 r_o=2|b|=2b以内的区域, 滑移面两侧原子间的错排能即 相当于位错核心能。错排能约占位错能的1/10, 可忽略
- (2) 弹性应变能 W_{el} , 在位错核心区以外, 长程应力场作用范围所具有的能量, 约占位错能的9/10。

材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

- 总之: (1) 位错的弹性应变能 $N_{e/\infty}$ InR,即随R缓慢地增加,所以位错具有长程应力场。
- (2)位错的能量是以单位长度的能量来定义的,直线位错更稳 它
- (3) 位错的弹性应变能可进一步简化为一个简单的函数式: W=aGb²。

式中W为单位长度位错线的弹性应变能,G是剪切模量。b是柏氏矢量, $\alpha=1/4\pi \ln R/r_0$ 其中R是晶体的外径、 r_0 是位错核心的半径,系数 α 由位错的类型、密度(R值)决定,其值的范围为 $0.5^{\circ}1.0$ 。

意义:上式表明₩∞b²,故可用柏氏矢量的大小来判断晶体哪些地 方最容易形成位错。

林科并膏与工程膏院 Shool of Material Science & Engineering

五、位错的运动

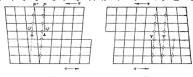
- 位错的滑移:指位错在外力作用下,在滑 移面上的运动,结果导致永久形变。
- 位错的攀移:指在热缺陷的作用下,位错在垂直滑移方向的运动,结果导致空位或间隙原子的增值或减少。

材料科学与工程学院

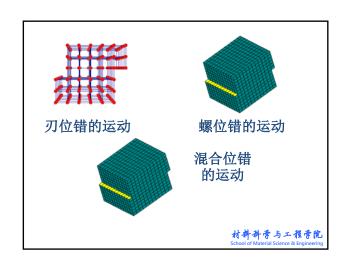
(一)、位错的滑移

1. 位错滑移的机理

位错在滑移时是通过位错线或位错 附近的原子逐个移动很小的距离完成的。



(a) 正刃位错滑移方向与外 (b) 负刃位错滑移方 力方向相图 向与外力方向相反 **刃位错的滑移**



2. 位错的滑移特点

- (1) 刃位错滑移方向与外力 Z及伯氏矢量 b 平行,正、负刃位错滑移方向相反。
- (2) 螺位错滑移方向与外力 7及伯氏矢量b 垂直,左、右螺型位错滑移方向相反。
- (3) 混合位错滑移方向与外力t及伯氏矢量 b成一定角度(即沿位错线法线方向滑 移)。
- (4) 晶体的滑移方向与外力T及位错的伯氏 矢量b相一致,但并不一定与位错的滑移 方向相同。

材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

(二)、位错的攀移

位错的攀移指在热缺陷或外力作用下, 位错线在垂直其滑移面方向上的运动,结果 导致晶体中空位或间隙质点的增殖或减少。 刃位错除了滑移外,还可进行攀移运动。

攀移的实质是多余半原子面的伸长或缩 短。螺位错没有多余半原子面,故无攀移运 动。

> 材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering

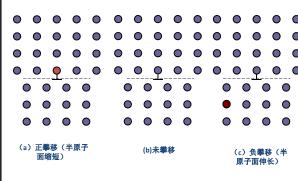


图2-17 刃位错攀移示意图

材料科学与工程学院

位错的攀移力(使位错发生攀移运动的力)包括:

- (1) 化学攀移力 F_s ,是指不平衡空位浓度施加给位错攀移的驱动力。
- (2) 弹性攀移力F_o, 是指作用于半原子面上的正应力分量作 用下,刃位错所受的力。

位错攀移的激活能U。由割阶形成的激活能U,及空位的扩散活化能U。两部分所组成。常温下位错靠热激活来攀移是很困难的。但是,在许多高温过程如蠕变、回复、单晶拉制中,攀移却起着重要作用。位错攀移在低温下是难以进行的,只有在高温下才可能发生。

材料科学与工程学院

六、位错的反应

由于位错间相互作用力的存在,使得位错之间有可能发生相互转化或相互作用, 此即位错反应。位错能否发生反应,取决于 两个条件:

> 其一,必须满足伯氏矢量的守恒性; 其二,必须满足能量条件。

> > 材料科学与工程学院

在同一滑移面的两个异向位错的相互作用,相互吸引、反应导致位错消失,变成完整晶体。

两个异向位错,在不同滑移面,上下错开 一个原子间距,反应结果生成一排空位。

同向位错,在不同滑移面,当两者所成角度〈45度时,压应力重叠,张应力重叠,结果 互相排斥,导致远离;当两者所成角度〉45度时,结果互相吸引,导致接近。